








	<h2 style="color: red;">FDP050AN06A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP050AN06A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP050AN06A0.pdf 2.FDP050AN06A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 80285 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP050AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	80285 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 18A (Ta), 80A (Tc) 245W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	245W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP050AN06A0 ist neu im Original, Suche FDP050AN06A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP050AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP050AN06A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP047NA08A0 FSC FDP047NA08A0 FSC</p>	 <p>FDP053N08B FSC FDP053N08B FSC</p>	 <p>FDP047N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220</p>	 <p>FDP050 FSC FDP050 FSC</p>
 <p>FDP050AN06A0 FSC FDP050AN06A0 FSC</p>	 <p>FDP053N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A TO-220</p>	 <p>FDP054N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDP030N06	↔ FDP030N06	⇒ FDP030N06B_F102	D FDP032N08	↔ FDP032N08
⊣ FDP032N08B	⊛ FDP036N10A	D FDP036N10A	⇒ FDP038AN06A0	↔ FDP038AN06A0
⊛ FDP038AN06AO	⊣ FDP039N08B	⊛ FDP040N06	↔ FDP040N06	↔ FDP045N10A
D FDP045N10A	⊛ FDP047AN08	⊣ FDP047AN08A0	⊛ FDP047AN08A0	↔ FDP047AN08A0
⇒ FDP047N08	↔ FDP047N08	⊛ FDP047N08AO	⊣ FDP047N10	↔ FDP047N10
↔ FDP050AN06A0	⇒ FDP050AN06A0	D FDP053N08B	⊛ FDP053N08B_F102	⊣ FDP054N10
⊛ FDP054N10	D FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0	↔ FDP060AN08A0	↔ FDP060N08A0
⊣ FDP060N08AO	⊛ FDP068AN08A0	↔ FDP070AN06A0	⇒ FDP070AN06A0	↔ FDP070AN06A0
⊛ FDP075N15A	⊣ FDP075N15A	⊛ FDP083N15A	D FDP083N15A	↔ FDP083N15A_F102
↔ FDP085N10A	⊛ FDP085N10A	⊣ FDP085N10A_F102	⊛ FDP090N10	↔ FDP090N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited